

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局



(43) 国际公布日:
2005年11月24日(24.11.2005)

PCT

(10) 国际公布号:
WO 2005/112256 A1

(51) 国际分类号⁷: H03H 7/24, H03F 1/30

(21) 国际申请号: PCT/CN2005/000586

(22) 国际申请日: 2005年4月28日(28.04.2005)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
200410027307.7 2004年5月18日(18.05.2004) CN

(71)(72) 发明人/申请人: 阎跃军(YAN, Yuejun) [CN/CN];
阎跃鹏(YAN, Yuepeng) [CN/CN]; 中国广东省深圳市
福田区滨河路爱地大厦西座16楼E, F座, Guangdong
518045 (CN)。

(74) 代理人: 北京润平知识产权代理有限公司(RUNPING
& PARTNERS); 中国北京市海淀区北四环西路9号银
谷大厦509室, Beijing 100080 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护):
AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW,
BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR,

HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ,
LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK,
MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH,
PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY,
TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN,
YU, ZA, ZM, ZW

(84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护):
ARIPO(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,
SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚专利(AM, AZ, BY,
KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 欧洲专利(AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,
IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK,
TR), OAPI(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)

根据细则4.17的声明:

— 发明人资格(细则4.17(iv))仅对美国

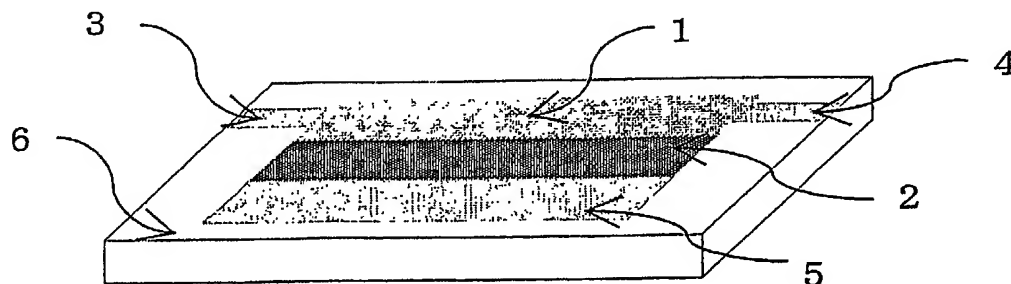
本国际公布:

— 包括国际检索报告。

所引用双字母代码和其它缩写符号, 请参考刊登在每期
PCT公报期刊起始的“代码及缩写符号简要说明”。

(54) Title: TEMPERATURE COMPENSATION ATTENUATOR

(54) 发明名称: 温度补偿衰减器



(57) Abstract: The present invention discloses a temperature compensation attenuator, comprising: a base (6), a thin film thermistor (1) on the base (6), an input terminal (3) and an output terminal (4) which are connected to the two ends of the thin film thermistor (1) respectively, and a thermistor (2), the top side of the thermistor (2) is electronically connected to the bottom side of the thermistor (1), the bottom side of the thermistor (2) is electronically connected to the ground. By connecting the temperature compensation attenuator of the present invention to the high frequency and microwave active circuit, it can compensate variance of the gain of the high frequency and microwave active device or the drift of the frequency characteristic of the active device due to the temperature variance. The temperature compensation attenuator of the present invention can be used in various of high frequency and microwave circuits and systems in particular, suitable for mobile communication systems, satellite communication systems and radar systems which require a strict temperature characteristic.

[见续页]



(57) 摘要

本发明公开了一种温度补偿衰减器，其包括：基体（6）、设置在该基体（6）上的薄膜热敏电阻（1）、分别连接到该薄膜热敏电阻（1）两端的输入端（3）和输出端（4）以及薄膜电阻（2），该薄膜电阻（2）的顶边与薄膜热敏电阻（1）的底边相电连接，薄膜电阻（2）的底边与接地端（5）相电连接。通过将本发明的温度补偿衰减器接入高频及微波有源电路中，可以补偿由于温度变化而带来的高频及微波有源器件的增益的变动或有源器件的频率特性的漂移。本发明的温度补偿衰减器可用于各种高频和微波电路及系统，尤其适合于温度特性要求严格的移动通信系统、卫星通信系统、雷达系统。

温度补偿衰减器

技术领域

5 本发明涉及电子及通信的高频及微波有源器件和系统温度特性补偿的温度补偿衰减器，可用于各种高频和微波电路及系统。尤其适合于温度特性要求严格的移动通信系统、卫星通信系统、卫星导航系统、雷达系统。

背景技术

10 为了减少高频及微波有源器件的温度特性的漂移。现有技术中采用的方法非常复杂，使用器件多，研发周期长，成本高，故障率高。例如，高频及微波功率放大器，其增益随着环境温度而变化，其输出功率也相应地发生变化，严重地影响了器件乃至整个系统的特性指标和安定性。为了减少环境温度变化引起的高频及微波功率放大器的增益和功率的变化，在系统中使用温度检知器，功率耦合器，检波器，信号编程处理器，15 存储器，具有自动增益控制(AGC)或自动功率控制(APC)功能的前置放大器等诸多有源器件，以及上述器件用的电源及控制系统。

为了解决温度特性的漂移，要求其器件做到：

- (1) 宽频带特性；
- 20 (2) 输入端和输出端都要有极小的反射系数；
- (3) 输入端和输出端有较大的隔离度；
- (4) 输入端和输出端的特性阻抗符合接入系统的要求。例如50欧姆，75欧姆等设计。

25 发明内容

本发明所要解决的技术问题在于提供一种温度补偿衰减器，其可实

现高频及微波电子通信的高频及微波有源器件和系统温度特性补偿。

为解决上述技术问题，本发明所采用的技术方案是：提供一种温度补偿衰减器，其包括：基体、设置在该基体上的薄膜热敏电阻、分别连接到该薄膜热敏电阻两端的输入端和输出端以及薄膜电阻，该薄膜电阻的顶边与薄膜热敏电阻的底边相电连接，薄膜电阻的底边与接地端相电连接。

该薄膜电阻的两端分别与输入端和输出端连接。

该薄膜电阻是薄膜热敏电阻，其温度特性与上述基体上的薄膜热敏电阻的温度特性相反。

10 本发明的有益效果是：利用薄膜热敏电阻，构成一种宽频带的随温度变化衰减量而变化的分布参数电路结构的温度补偿衰减器。通过将温度补偿衰减器接入高频及微波有源电路中，可以补偿由于温度变化而带来的高频及微波有源器件的增益的变动或有源器件的频率特性的漂移，即使在恶劣的环境温度变化的条件下，也可以保证高频及微波有源器件的增益安定不变或补偿有源器件的频率特性的漂移。

附图说明

图1是本发明具有分布参数电路结构的温度补偿衰减器的第一较佳实施例的示意图。

20 图2是图1所示温度补偿衰减器的电路原理图。

图3是本发明具有分布参数电路结构的温度补偿衰减器的第二较佳实施例的示意图。

图4是图3所示温度补偿衰减器的电路原理图。

25 图5是本发明温度变化时理想特性的串联热敏电阻值与并联热敏电阻值的理论变化曲线。

图6是本发明温度变化时温度补偿衰减器的衰减量或以增益表达时的增益量变化曲线。

图7是本发明温度补偿衰减器接入放大器前补偿放大器等器件增益变动的示意图。

5 图8是本发明温度补偿衰减器接入有源器件前补偿有源器件器件的示意图。

具体实施方式

请参阅图1，本发明第一较佳实施例温度补偿衰减器包括基体6，在
10 基体6的表面层上形成薄膜热敏电阻1，薄膜热敏电阻1的两端分别与输入端3和输出端4相连接，薄膜热敏电阻1的底边与在基体6的表面层上形成的薄膜电阻2的顶边相电连接，薄膜电阻2的底边与接地端5相电连接。

薄膜电阻2可选用与薄膜热敏电阻1的温度特性相反的薄膜热敏电阻，这样温度补偿衰减器的温度补偿特性会更好。

15 以下，把薄膜电阻2可理解为薄膜热敏电阻。

由于薄膜热敏电阻1和薄膜电阻2的电阻值和温度系数不一样，薄膜热敏电阻1和薄膜电阻2的形成通过掩膜工艺技术在基体6的表面层上分别实现。先在基体6上印刷上薄膜热敏电阻1，使薄膜热敏电阻1的一端与输入端3连接，反向的另一端与输出端4连接；在基体6上再印刷上薄膜电阻2，使薄膜电阻2的顶边与薄膜热敏电阻1的底边相电连接，薄膜电阻2的底边与接地端5相电连接。最后在薄膜热敏电阻1和薄膜电阻2表面涂上保护膜，防止外部湿气和尘埃的侵入。

请参阅图2，它是图1所示温度补偿衰减器的分布参数的电路原理图。在图2中，可以将薄膜热敏电阻1和薄膜电阻2的结合等效成无数个微小的
25 串联和并联构成的二端口电阻器网络。根据需要的增益温度补偿量，即

根据要求的各温度下的二端口网络的衰减量、隔离度和反射系数，计算出薄膜热敏电阻1和薄膜电阻2的单位宽度和长度的电阻值，以及薄膜热敏电阻1和薄膜电阻2的温度系数。通过计算知道，为了实现小的反射系数和较高的输出输入端的隔离度的温度补偿衰减器，要求此温度补偿衰减器的在温度变化时，薄膜热敏电阻1的温度系数与薄膜电阻2的温度系数需要具有不同的特性。若薄膜热敏电阻1与薄膜电阻2都是相同正的温度系数，或者都是相同负的温度系数的话，不能符合实现小的反射系数和较高的输出输入端的隔离度的温度补偿衰减器的要求。

对于温度升高时，增益和功率随之减小的高频及微波有源器件的温度补偿来讲，为了保持增益和功率不受温度变化的影响，薄膜热敏电阻1采用具有随温度升高而电阻值减小的负温度系数的热敏电阻；薄膜电阻2可以采用具有随温度升高而电阻值增大的正温度系数的热敏电阻。

对于温度升高时，增益和功率随之变大的高频及微波有源器件的温度补偿来讲，为了保持增益和功率不受温度变化的影响，薄膜热敏电阻1采用具有随温度升高而电阻值增大的正温度系数的热敏电阻；薄膜电阻2可以采用具有随温度升高而电阻值减小的负温度系数的热敏电阻。

对于温度变化时，所要求补偿的衰减量较小的温度补偿衰减器来讲，要求薄膜热敏电阻1的温度系数的绝对值要远大于薄膜电阻2的温度系数的绝对值。

对于温度变化时，所要求补偿的衰减量较大的温度补偿衰减器来讲，要求薄膜热敏电阻1的温度系数的绝对值要略等于薄膜电阻2的温度系数的绝对值。

从电极的封装构造上可以做出表面实装型温度补偿衰减器，也可做出管腿引线式和插接线式温度补偿衰减器。

将输入端和输出端的特性阻抗设计为符合接入系统的要求的特性阻

抗。例如50欧姆。

请参阅图3，本发明第二较佳实施例温度补偿衰减器与第一较佳实施例的区别在于，薄膜电阻2的两端也分别与输入端3、输出端4连接。

其具体的制作方法与第一较佳实施例所描述的方法基本相同。

5 本发明第二较佳实施例温度补偿衰减器包括基体6，在基体6的表面层上形成薄膜热敏电阻1，薄膜热敏电阻1的两端分别与输入端3和输出端4相连接，薄膜热敏电阻1的底边与在基体6的表面层上形成的薄膜电阻2的顶边相电连接，薄膜电阻2的底边与接地端5相电连接，薄膜电阻2的两端也分别与输入端3、输出端4连接。

10 薄膜电阻2可选用与薄膜热敏电阻1的温度特性相反的薄膜热敏电阻，这样温度补偿衰减器的温度补偿特性会更好。

由于薄膜热敏电阻1和薄膜电阻2的电阻值和温度系数不一样，薄膜热敏电阻1和薄膜电阻2的形成通过掩膜工艺技术在基体6的表面层上分别实现。先在基体6上印刷上薄膜热敏电阻1，使薄膜热敏电阻1的一端与
15 输入端3连接，反向的另一端与输出端4连接；在基体6上再印刷上薄膜电阻2，使薄膜电阻2的顶边与薄膜热敏电阻1的底边相电连接，薄膜电阻2的底边与接地端5相电连接；薄膜电阻2的两端也分别与输入端3、输出端4连接。最后在薄膜热敏电阻1和薄膜电阻2表面涂上保护膜，防止外部湿气和尘埃的侵入。

20 请参阅图4，它是图3所示温度补偿衰减器的分布参数的电路原理图。在图3中，可以将薄膜热敏电阻1和薄膜电阻2的结合等效成无数个微小的并联和串联构成的二端口电阻器网络。根据需要的增益温度补偿量，即根据要求的各温度下的二端口网络的衰减量、隔离度和反射系数，计算出薄膜热敏电阻1和薄膜电阻2的单位宽度和长度的电阻值，以及薄膜热
25 敏电阻1和薄膜电阻2的温度系数。为了实现小的反射系数和较高的输出

输入端的隔离度的温度补偿衰减器，要求此温度补偿衰减器的在温度变化时，薄膜热敏电阻1的温度系数与薄膜电阻2的温度系数需要具有不同的特性。若薄膜热敏电阻1与薄膜电阻2都是相同正的温度系数，或者都是相同负的温度系数的话，不能符合实现小的反射系数和较高的输出输入端的隔离度的温度补偿衰减器的要求。

对于温度升高时，增益和功率随之减小的高频及微波有源器件的温度补偿来讲，为了保持增益和功率不受温度变化的影响，薄膜热敏电阻1采用具有随温度升高而电阻值减小的负温度系数的热敏电阻，薄膜电阻2可以采用具有随温度升高而电阻值增大的正温度系数的热敏电阻。

对于温度升高时，增益和功率随之变大的高频及微波有源器件的温度补偿来讲，为了保持增益和功率不受温度变化的影响，薄膜热敏电阻1采用具有随温度升高而电阻值增大的正温度系数的热敏电阻，薄膜电阻2可以采用具有随温度升高而电阻值减小的负温度系数的热敏电阻。

对于温度变化时，所要求补偿的衰减量较小的温度补偿衰减器来讲，要求薄膜热敏电阻1的温度系数的绝对值要远小于薄膜电阻2的温度系数的绝对值。

对于温度变化时，所要求补偿的衰减量较大的温度补偿衰减器来讲，要求薄膜热敏电阻1的温度系数的绝对值要略等于薄膜电阻2的温度系数的绝对值。

将输入端和输出端的特性阻抗设计为符合接入系统的要求的特性阻抗。例如50欧姆。

请参阅图5，它显示了温度变化时，负温度特性的单位面积的薄膜热敏电阻1与正温度特性的单位面积的薄膜电阻2的理论变化曲线。串联热敏电阻即薄膜热敏电阻1的温度系数与并联热敏电阻即薄膜电阻2的温度系数需要具有相反的温度特性。

请参阅图6，它显示了温度变化时按上述图5变化曲线作出的温度补偿衰减器的衰减量或以增益表达时的增益量变化曲线。设计制作温度补偿衰减器时，按图5的温度变化曲线选择串联热敏电阻即薄膜热敏电阻1和并联热敏电阻即薄膜电阻2就可以实现温度补偿衰减器的温度变化时所需要的衰减量的变化。

请参阅图7，它展示了温度补偿衰减器接入放大器前补偿放大器等器件增益变动的情况。如温度升高时，放大器的增益会减小，加入温度补偿衰减器后，其增益会补偿过来，全体可构成一个有着稳定增益的功率放大器系统，即使在环境温度变化的条件下，也可以保持放大器等器件的增益和输出功率不会因环境温度变化而发生变化，即用牺牲一部分的系统增益换取系统的稳定。

请参阅图8，它展示了温度补偿衰减器接入有源器件前补偿有源器件的情况。与放大器同样，温度补偿衰减器也可以接入到其他的高频及微波有源器件，比如接入高频及微波二极管功率检波器前，或接入微波二极管衰减器前，都可以补偿高频及微波有源器件特性的温度漂移。

可以理解，上述薄膜热敏电阻1和薄膜电阻2的几何形状不限于四边形，其也可以是其他的形状。薄膜热敏电阻1和薄膜电阻2的接触边的接触形式不限于单边接触，其也可以是：薄膜热敏电阻1的一边和薄膜电阻2的多边电接触、薄膜热敏电阻1的多边和薄膜电阻2的一边电接触、或者薄膜热敏电阻1的多边和薄膜电阻2的多边电接触等形式。

在上述二较佳实施例，薄膜热敏电阻1、薄膜电阻2、输入端3、输出端4以及接地端5在同一平面内，当然，其亦不限于在同一平面内，可位于不同的平面。

本发明构成一种分布参数电路结构的增益和电平的温度补偿衰减器。将其接入高频及微波有源电路中，可以补偿由于温度变化而带来的

高频及微波有源器件的增益的变动或有源器件的频率(RF)特性的漂移,即使在环境温度变化恶劣的条件下,也可以保证高频及微波有源器件的增益安定不变或补偿有源器件的RF特性的漂移。

本发明具有以下优点:

5 (1)具有极宽的频带,极小的反射系数,较好的隔离度。

(2)由于本发明是无源器件,成本低,体积小,制作简单,可靠性好。适合于轻量移动通信终端。

(3)不需要复杂的控制方式和器件,使用非常方便简单。例如,为了补偿环境温度变化引起的高频及微波功率放大器的增益或功率的变化,10 只需测出此功率放大器在高低温时的增益或功率的变化量。根据需要在功率放大器前、后,甚至在放大器内部加入恰好能补偿增益或功率的变化量的与其对应的温度补偿衰减器即可。

(4)不需要解决信号的同步问题。

(5)非常适合室外及恶劣条件下的设置的通信设备,如移动通信直15 放站、广播电视塔放、公用天线设备、卫星接收高频头、卫星导航(GPS),无线连接(WLAN)等等。

(6)适合于发热功率器件而引起的增益或功率的变化的补偿。如移动通信基站发射机开机之后短期和长期发热状态而引起的增益或功率的变化。

20 (7)适合于对室内温度变化要求高的仪表或测试器。

(8)根据系统安装的要求,可将此发明除表面实装型温度补偿衰减器之外,也可做成管腿引线式和插接线式温度补偿衰减器。

权利要求书

1. 一种温度补偿衰减器，其包括：基体（6）、设置在该基体（6）上的薄膜热敏电阻（1）和分别连接到该薄膜热敏电阻（1）两端的输入端（3）和输出端（4），其特征在于：该温度补偿衰减器还包括一个薄膜电阻（2），该薄膜电阻（2）的顶边与薄膜热敏电阻（1）的底边相电连接，薄膜电阻（2）的底边与接地端（5）相电连接。

2. 据权利要求1所述的温度补偿衰减器，其特征在于：该薄膜电阻（2）的两端分别与输入端（3）和输出端（4）连接。

3. 根据权利要求1或2所述的温度补偿衰减器，其特征在于：该薄膜电阻（2）是薄膜热敏电阻，其温度特性与上述基体（6）上的薄膜热敏电阻（1）的温度特性相反。

4. 根据权利要求3所述的温度补偿衰减器，其特征在于：该薄膜热敏电阻（1）是随温度升高电阻值变小的负温度系数的热敏电阻；该薄膜电阻（2）是随温度升高电阻值变大的正温度系数的热敏电阻。

5. 根据权利要求3所述的温度补偿衰减器，其特征在于：该薄膜热敏电阻（1）是随温度升高电阻值变大的正温度系数的热敏电阻；该薄膜电阻（2）是随温度升高电阻值变小的负温度系数的热敏电阻。

6. 根据权利要求3所述的温度补偿衰减器，其特征在于：该薄膜热敏电阻（1）及薄膜电阻（2）的数值和温度系数根据增益和电平补偿量选择，其满足衰减量、隔离度和反射系数大小。

7. 根据权利要求1或2所述的温度补偿衰减器，其特征在于：该薄膜热敏电阻（1）及薄膜电阻（2）的任何一种电阻分布参数为串联、并联或串并联的电阻复合体。

5 8. 根据权利要求1或2所述的温度补偿衰减器，其特征在于：该薄膜热敏电阻（1）和薄膜电阻（2）的接触边的接触形式为：薄膜热敏电阻（1）的一边和薄膜电阻（2）的多边电接触、薄膜热敏电阻（1）的多边和薄膜电阻（2）的一边电接触、或者薄膜热敏电阻（1）的多边和薄膜电阻（2）的多边电接触。

10

9. 根据权利要求8所述的温度补偿衰减器，其特征在于：该薄膜热敏电阻（1）、薄膜电阻（2）、输入端（3）、输出端（4）以及接地端（5）在同一平面内，或者在不同的平面内。

15

10. 根据权利要求1或2所述的温度补偿衰减器，其特征在于：该温度补偿衰减器为表面实装型、引线型或插接线型的结构。

11. 根据权利要求1或2所述的温度补偿衰减器，其特征在于：该温度补偿衰减器采用印刷薄膜热敏电阻和多层掩膜加工工艺集成到基体

20

（6）上。

1/4

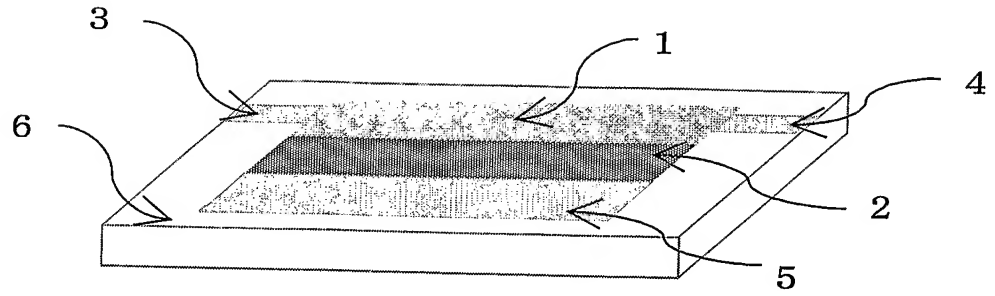


图 1

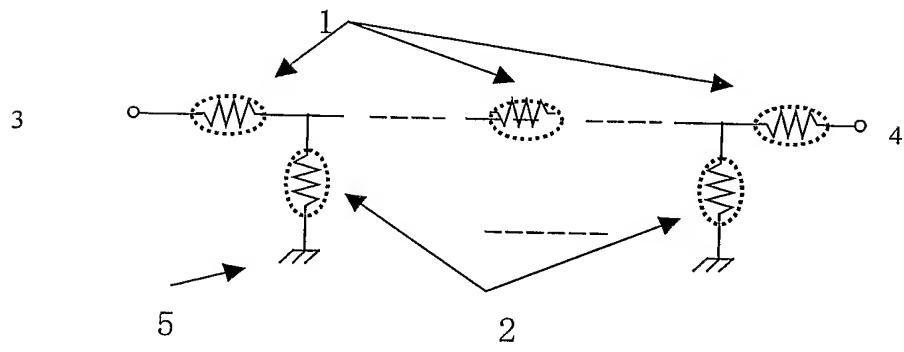


图 2

2/4

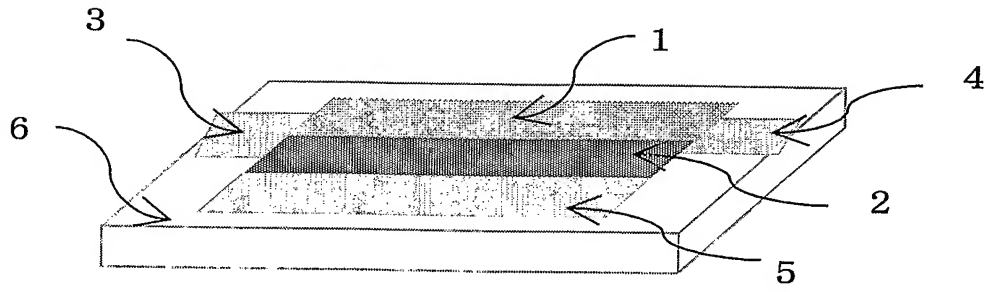


图 3

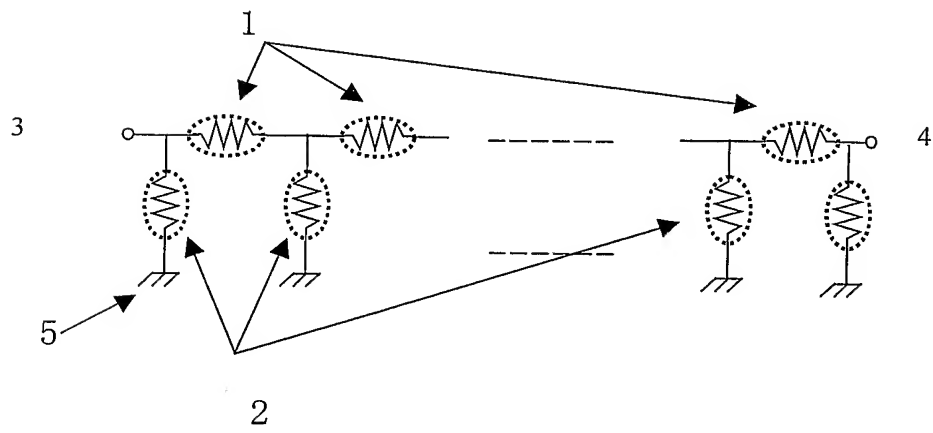


图 4

3/4

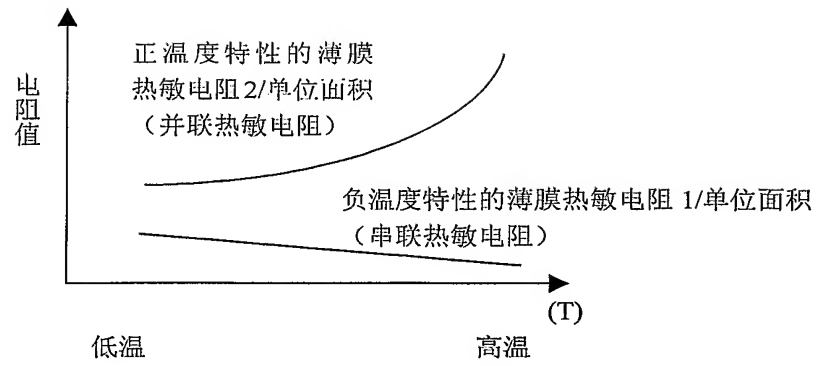


图 5

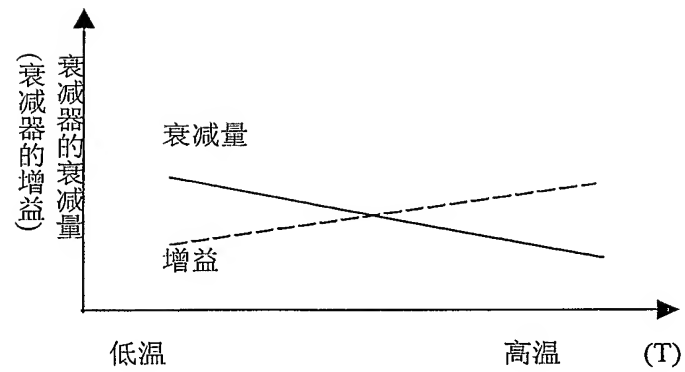


图 6

4/4

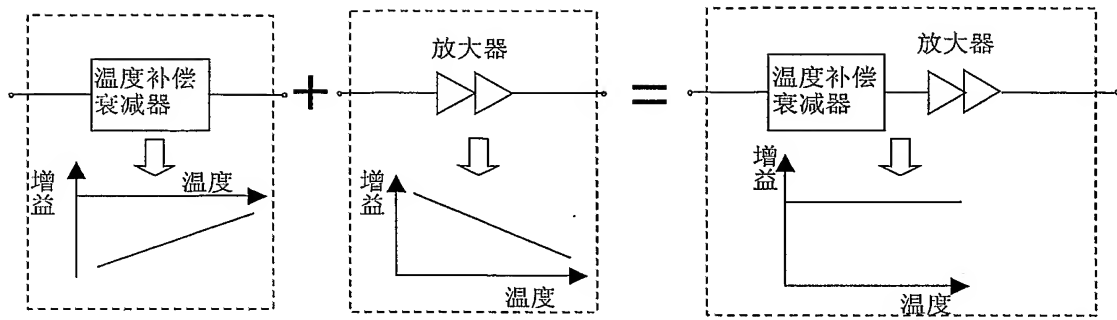


图 7

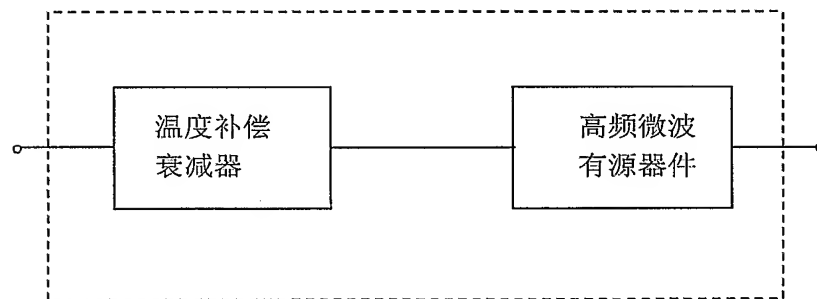


图 8

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2005/000586

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC7: H03H7/24 H03F1/30

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC7: H03H7/24 H03F1/30 G01K7/24

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

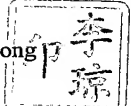
CNPAT EPODOC WPI PAJ CNKI

temperature compensat+ attenuat+ drift thermistor thermister resistance film amplifier gain base

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP2000-196395A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) 14.Jul 2000 (14.07.2000) abstract col4,row 18 to col10,row9 fig 1-11	1-11
A	JP10-32442A (KYOCERA CORP) 03.Feb 1998 (03.02.1998) the whole document	1-11
A	CN1417566A (BEIJING LAIMU ELECTRONICS CO) 14.May 2003 (14.05.2003) the whole document	1-11

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.

<p>* Special categories of cited documents:</p> <p>“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</p> <p>“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date</p> <p>“L” document which may throw doubts on priority claim (S) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</p> <p>“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</p> <p>“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p>		<p>“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</p> <p>“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</p> <p>“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art</p> <p>“&” document member of the same patent family</p>
<p>Date of the actual completion of the international search</p> <p>08.Aug 2005 (08.08.2005)</p>		<p>Date of mailing of the international search report</p> <p>25 · AUG 2005 (25 · 08 · 2005)</p>
<p>Name and mailing address of the ISA/CN</p> <p>6,Xitucheng Road,Jimen Bridge,Haidian District, Beijing,100088 P.R.China</p>		<p>Authorized officer</p> <p>Li,Qiong </p> <p>Telephone No. (86-10)62084932</p>
<p>Facsimile No. (86-10)62019451</p>		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2005/000586

JP2000-196395A	14.Jul 2000 (14.07.2000)	null
JP10-32442A	03.Feb 1998 (03.02.1998)	null
CN1417566A	14.May 2003 (14.05.2003)	null

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN2005/000586

A. 主题的分类

IPC7: H03H7/24 H03F1/30

按照国际专利分类表(IPC)或者同时按照国家分类和 IPC 两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)

IPC7: H03H7/24 H03F1/30 G01K7/24

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用))

CNPAT EPDOC WPI PAJ CNKI

温度 补偿 衰减器 漂移 热敏电阻 薄膜 放大器 增益 基体

C. 相关文件

类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求
X	JP2000-196395A (三菱电机株式会社) 14.7 月 2000 (14.07.2000) 摘要, 第 4 栏第 18 行至第 10 栏第 9 行, 图 1-11	1-11
A	JP10-32442A (KYOCERA CORP) 03.2 月 1998 (03.02.1998) 全文	1-11
A	CN1417566A (北京莱姆电子有限公司) 14.5 月 2003 (14.05.2003) 全文	1-11

☐ 其余文件在 C 栏的续页中列出。

☒ 见同族专利附件。

* 引用文件的具体类型:

“A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件

“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利

“L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件

“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

“T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件

“X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性

“Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性

“&” 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期

08.8 月 2005 (08.08.2005)

国际检索报告邮寄日期

25 · 8 月 2005 (25 · 08 · 2005)

中华人民共和国国家知识产权局(ISA/CN)

中国北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 100088

传真号: (86-10)62019451

受权官员

电话号码: (86-10)62084932



国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号
PCT/CN2005/000586

检索报告中引用的 专利文件	公布日期	同族专利	公布日期
JP2000-196395A	14.7 月 2000 (14.07.2000)	无	
JP10-32442A	03.2 月 1998 (03.02.1998)	无	
CN1417566A	14.5 月 2003 (14.05.2003)	无	